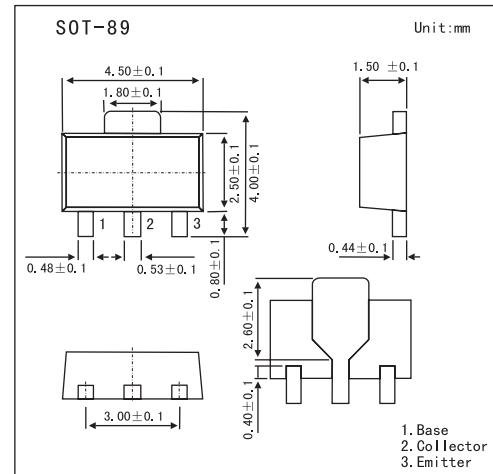


■ Features

- High current (max. 600 mA)
- Low voltage (max. 40 V).



■ Absolute Maximum Ratings Ta = 25°C

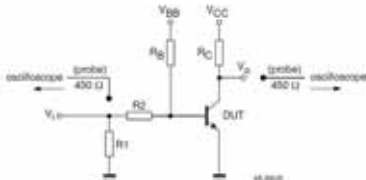
Parameter	Symbol	Rating	Unit
Collector-base voltage	V _{CB0}	60	V
Collector-emitter voltage	V _{CEO}	40	V
Emitter-base voltage	V _{EB0}	5	V
Collector current	I _c	600	mA
Peak collector current	I _{CM}	800	mA
Peak base current	I _{BM}	200	mA
Total power dissipation	P _{tot}		
	* 1	0.5	W
	* 2	0.8	
	* 3	1.1	
Storage temperature	T _{stg}	-65 to +150	°C
Junction temperature	T _j	150	°C
Operating ambient temperature	R _{amb}	-65 to +150	°C
Thermal resistance from junction to ambient	R _{th(j-a)}		
	* 1	250	K/W
	* 2	156	
	* 3	113	
Thermal resistance from junction to soldering point	R _{th(j-s)}	30	K/W

*1 Device mounted on a printed-circuit board, single-sided copper, tin-plated and standard footprint.

*2 Device mounted on a printed-circuit board, single-sided copper, tin-plated and mounting pad for collector 1 cm².

*3 Device mounted on a printed-circuit board, single-sided copper, tin-plated and mounting pad for collector 6 cm².

■ Electrical Characteristics Ta = 25°C

Parameter	Symbol	Testconditons	Min	Typ	Max	Unit
Collector cutoff current	ICBO	IE = 0; VCB = 60 V			50	nA
Emitter cutoff current	IEBO	IC = 0; VEB = 6 V			50	nA
DC current gain *	hFE	VCE = 1 V, IC = 150 mA	100		300	
collector-emitter saturation voltage *	VCEsat	IC = 150 mA; IB = 15 mA			400	mV
		IC = 500 mA; IB = 50 mA			750	mV
base-emitter saturation voltage *	VBEsat	IC = 150 mA; IB = 15 mA			950	mV
		IC = 500 mA; IB = 50 mA			1.2	V
Collector capacitance	Cc	IE = iE = 0; VCB = 5 V; f = 1 MHz			8	pF
Emitter capacitance	Ce	IC = iC = 0; VEB = 500 mV; f = 1 MHz			30	pF
Transition frequency	fT	IC = 20 mA; VCE = 10 V; f = 100 MHz	250			MHz
Turn-on time	ton	 <p> $V_i = 9.5 \text{ V}$; $T = 500 \mu\text{s}$; $t_p = 10 \mu\text{s}$; $t_r = t_f \leq 3 \text{ ns}$. $R_1 = 68 \Omega$; $R_2 = 325 \Omega$; $R_B = 325 \Omega$; $R_C = 160 \Omega$. $V_{BB} = -3.5 \text{ V}$; $V_{CC} = 29.5 \text{ V}$. Oscilloscope: input impedance $Z_i = 50 \Omega$. </p>			35	ns
Delay time	td				15	ns
Rise time	tr				20	ns
Turn-off time	toff				250	ns
Storage time	ts				200	ns
Fall time	tf				60	ns

* Pulse test: $t_p \leq 300 \text{ ms}$; $\delta \leq 0.02$.

■ Marking

Marking	2X
---------	----



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331